```
** Result [P ] ** Format(P805) 2006.02.03
                                                   1/
                                          1980-113515[1980/ 8/20]
Application No./Date:
                                          1981- 37834 Translate [1981/ 4/11]
Public Disclosure No./Date:
                                              1282844 [1985/ 9/27]
Registration No./Date:
Examined Publication Date (present law):
Examined Publication No./Date (old law): 1984- 9086 Translate [1984/ 2/29]
PCT Application No.:
PCT Publication No./Date:
                                                      [
                                                                 ]
Preliminary Examination:
                                           ()
                                            ] (
Priority Country/Date/No.: ( ) [
Domestic Priority:
                                                      [1980/ 8/20]
Date of Request for Examination:
Accelerated Examination:
                                           ( )
                                           (8000)
Kind of Application:
                                                      [1979/ 7/20](S)
Critical Date of Publication:
No. of Claims:
                                           ( 1)
Applicant: HITACHI LTD
Inventor: AIKI KUNIO, OSHIMA MASAHIRO
                                               =G06K 7/10
IPC: G11B 7/12
                          =G02B 27/00
  =H01S 3/096
                        C H01S
                                             G02B 27/00
      G06K 7/10
 G11B 7/09
                   B G11B 7/125
                                      A HO1S
F-Term:
5F073AA15,BA04,EA01,EA27,GA38,5B072CC16,DD02,HH20,LL12,5D118AA23,CB07,
5D119AA17, AA19, BA01, BB01, FA05, HA12, HA14, HA38, HA40, HA41, HA68, 5D118DA25, 5D789A
   A17, AA19, BA01, BB01, FA05, HA12, HA14, HA38, HA40, HA41, HA68
Expanded Classicication: 425,422,446
Fixed Keyword: R002,R102
Citation: [ ,
                                   ] ( , ,
                                                     )
```

Abstract: PURPOSE: To obtain an optical pickup that generates no noise by permitting a semiconductor laser to oscillate infixed multiplex longitudinal mode. CONSTITUTION: Semiconductor laser 1 is driven by electric current supplied from two electric power sources, DC electric power source 5 and high-frequency current source 6, to provide multiplex longitudinal mode oscillation and laser light that corresponds to the oscillation spectrum focuses on video disk 2 through condenser lenses 41 and 42 to pick up information on disk 2. Through this multiplex longitudinal mode oscillation, a light output varies smoothly against displacement due to the flopping of disk 2 and fluctuations of the light output in which the displacement of disk 2 happens at intervals of $\lambda/2$ are suppressed, suppressing a low frequency range noise perfectly. Here, λ represents the wavelength of the laser light. Simultaneously, the high-frequency driving multiplex longitudinal mode oscillation reduces the video noise level, so that an optical pickup can be obtained which generates no noise.COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

Title of Invention: OPTICAL PICKUP

爾日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公告

⑫特 許公 载(B2) 昭59-9086

@Int.Cl.3 G 11 B G 02 B G 06 K H 01 S 3/096

庁内整理番号 識別記号

匈匈公台 昭和59年(1984)2月29日

A-7247-5D 6952-

発明の数 1

(全7頁)

1

90光学的情報再生裝置

20特

頤 昭55-113515

您出 顧 昭54(1979)7月20日

(前実用新案出願日援用)

63公

网 昭56--37834

鐵略56(1981) 4 月11日

179克 明 省 相木 国男

国分寺市東恋ケ海1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 10

70 発明 者尾島正啓

国分寺市東恋ケ盗1丁目 280 養地 株式会社日立製作所中央研究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所・

6 密地

四代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外2名

の特許諸求の範囲

1 情報記録媒体上にレーザ光を照射するための 半導体レーザ素子と、該情報記録媒体からの反射 光を利用して該情報記録媒体に記録された情報に 対応する電気信号を得るための光電変換手段とか らなる光学的情報再生装置において、上記半導体 で発掘する半導体レーザ素子であると共に、該半 導体レーザ素子が多重縦モードで発掘するように 上記直流電流に重畳される高周波電流を供給する 高周波電流源を有することを特徴とする光学的情 報再生裝置。

- 2 上記高周波電流の高波数は、上記情報記録媒 体に記録された上記情報の題波数の5倍以上であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 光学的情報再生藝聞。
- 3 上記高周波電流の周波数は、50 MHz以上で 35 レーザ発掘が起こる。 あるととを特徴とする特許請求の顧問第1項記載 の光学的情報再生装置。

発明の評細な説明

本発明は、光学的に情報を再生する光学的情報 再生装置、特に半導体シーザを光源として用いた 光学的情報再生装置に関する。

2

光ビデオアイスクや光PCMオーアイオデイス クから光学的に情報を再生する情報再生装置には、 光浪として半導体レーザを用いた光学的ピツクチ ップが用いられる。この光学的ピックアップには 従来二種類のものがある。

その第1は、情報記録媒体からの反射光を光源 たる半減体レーザに帰棄することにより、反射性 の変化を半導体シーザの出力光の変化に変換し、 この出力光の変化を受光器で検出することによつ て記録情報に対応した電気信号を得るものである。 東京都千代田区神田駿河台4丁目 25 との光学的ピックアツブは、いわゆるSCOOPで (Self-Coupled Optical Pickup) と呼ば れている。

第1図は、上記SCOOPによる情報再生装置の 郷略構成図である。 1 は半導体レーザ、 2 は骨報 記憶媒体を有するデイスクである。その媒体は例 えば円板状の基板に設けられており、凹凸あるい は反射率変化として、情報を記録する。3は光検 出器、41は半導体レーザからの光を平行光東に するためのレンズ、42はレーザ光を、デイスク レーザ索子が、直流管流駆動により単一縦モード 25 2の表面上で、光の波長程度の長さのスポット径 に集光するためのレンズである。この装置では、 半導体レーザ1から射出されたレーザ光はレンズ 41,42によりデイスク2上の情報記憶媒体に 照射され、記録情報に応じた変調を受けて反射さ 30 れる。この変調された反射光は同じ光路を戻り半 選体レーザ1に帰還される。デイスク2が半導体 レーザの発振器の一部になつていることが特徴で ある。即ち半導体結晶の2つのへき頭と、デイス ク2との、3枚の鏡でつくる光共復器によって、

> この装置に於ては、デイスク2からの反射光の 光量の変化に応じて半導体レーザの発振光出力が

変化するので、この発振出力光の変化を光検出器 3で検出することにより反射光の変化を検出して デイスクに記録されてある情報信号に対応した電 気信号を得る。この装置の特徴は、構成部品点数 が少なくて済むので、小型化、軽量化、低価格化 5 を特徴とするものである。 ができ、更に光学調整が容易な点にある。一方、 この方式の欠点の一つに、信号の殺音レベルが高 い事があげられる。

第2の光ピツクアツブは、上記光デイスクから の反射光を半導体レーザに帰還することなく、直 10 れない場合に、横モードが制御された半導体レー 接光検出器で受光することにより記録情報に対応 した電気信号を得るものである。この第2の光ピ ツクアツブは、例えば第1図に示す装置において 説明すれば、次のように構成される。即ち、光デ イスク2からの反射光が、半導体レーザ1に帰還 15 一つの綴モードに、レーザ光エネルギーが築中す されないように、半導体レーザーとデイスク2と の間に1/4波長板と偏光プリズムを挿入するの である。この場合の光ピツクアツブを以下に於て は、従来型の光学的ピックアップと呼ぶことにす る。従来型の光ピンクアツプにおいても、デイス 20 に伴なつて、単一発援縦モードが、腱りの単一縦 クからの反射光がレーザに全く帰還しないわけで はない。 PCMオーデイオデイスクやピデオデイ スクでは高分子樹脂を用いて、レプリカデイスク を大量生産するが、レブリカ成型時に生じる応力 のために、レプリカデイスクはわずかな複歴折性 25 を持つ。従つて、従来型光ピックアップでレプリ カデイスクから情報再生する場合には、レブリカ デイスクの持つ複屈折性のために、デイスクから の反射光の一部が、半導体レーザに帰還される。 更に1/4波曼板や偏光プリズムの光学的調整ず 30 共振モードスペクトルが変化することによって引 れや、部品性能のぼらつき等の原因によっても、 デイスクからの反射光が、半導体レーザに帰還さ れる。結局、従来型のピツクアツブにおいても、 デイスクからの反射光の数%は、半導体レーザに 帰還され、レーザの雑音レベルを高くしてしまう。35 以上を要するに、半導体レーザを用いた光ピツ クアップでは、SCOOPでも、従来型でも、反射 光帰還による、半導体レーザのノイズ発生が問題 である。半導体レーザのノイズレベルが高いと、 PCMオーデイオプレーヤでは、音質の劣化を、 ビデオデイスクプレーヤでは画質の劣化を引き起

本発明の目的は、半導体レーザを光源として用 いた光学的情報再生装置において、上途の雑音の

とす。

発生を抑止した情報再生装置を提供するものであ る。かかる目的を達成するために、本発明は半導 体レーザを直流電流に高周波電流を重畳した電流 により駆動して多章艇モードで発掘せしめること

以下、まず半導体レーザを光源として用いた場 合に発生する雑音について詳細に説明する。 第1 図に示す装置において、デイスク2がなく、した がつて反射光の帰還が、半導体レーザーに施こさ ザを直流電流で駆動すると、単一終モード発振す る。これは半導体レーザが、ほば均一な利得スペ クトルを有しているために、直流電流駆動による 定常発振時には、利得が損失を上まわつた、ある るからである。

しかしながら、デイスク2が有り、反射光の帰 **還が半導体レーザに施こされる場合、半導体レー** ザを直流電流で駆動すると、ディスクの微小変位 モードへジャンプしたり、数本の縦モードが同時 発振したりする。反射光帰還がある半導体レーザ の雑音レベルが高い原因は、このような、発振機 モードの変化にある。

発掘縦モードの変化は、半導体レーザのデイス ク側面と、デイスク面とでつくる外部光共振器の 共振モードと、半導体結晶の2つのへを開面でつ くる光共級器の共振モード(縦モード)とが競合 し、かつデイスクの変位に伴なって外部共振器の き起こされる。

単一縦モード発振と多重縦モード発振とは、デ イスクがレーザ発振波長の半分(*1/2*こ 0.4 gm) 変位する毎に、交互に起こる。これは、デイスク と半導体レーザ端面とがつくる外部共振器の鉄振 条件が、同一波長に対しては、 1/2年に同一に なるからである。

反射光帰避時に発生するレーザノイズには、 2 種類あり、第1のノイズは、単一縦モード発振と 40 多量縦モード発振とが、デイスクの 1/2 毎の変位 に対応して交互に起こることに原因する。単一統 モード発振時の光出力は大きく、多量緩モード発 振時の光出力は小さい。従がつて、レーザ光出力 は、デイスクが 1/2 変位する毎に変化する。発

振縦モードが、単一か多重かに依つて、光出力が 異なる原因は、外部共振器を一枚の鏡とみなした 場合の有効反射率が、単一縦モード発振時は大き く多重縦モード発振時は小さいことにある。単一 縦モード発掘は、外部共振器の有効反射率が最大 となるようなモードが選択されて起こる。 多量機 モード発振では、発振している概本かのモードの すべてについて、外部共振部の有効反射率を最大 にすることはできないので、平均としては、単一 **綾モード発掘時の有効反射率より小さくなる。レ** ーザ共振器を構成する鏡の反射率が高い程、損失 は小さく、発掘しきい電流が小さくなり、一定電 施下では光出力が大きい。従つて、単一縦モード 発振時の方が、光出力は大きい。発振縦モードが 単一か多量かによる光出力変動の間波数帯域は、 デイスクと半導体レーザとの距離が、1/2変化 する速さによつて突まり、デイスクのばたつき、 回転数や自動焦点制御の性能に依存するが、ほぼ、 KHz~数10KHzの低帯域にある。

クトルノイズで、多重旋モード発援時に生じる。 ビデオデイスクからの再生で、ビデオ信号の 3/Nを劣化させる。ここでは、この2種のノイ ズをビデオ帯域ノイズと呼ぶことにする。この丿 イズは反射光帰還がある場合でも、発振縦モード 25 が単一である場合には発生しない。反射光帰還に よつて多重縦モード発振しているときに限つて、 ビデオ帯域ノイズが発生する。実際には、デイス クが 1/2変動する母に、単一凝モード発掘と多 域ノイズは必ず発生する。

次に、図を用いてノイズ発生の実際を詳しく説 明する。

ディスクと半導体レーザとの間の距離が、時間 とともに変化する場合、発掘縦モードの変化に伴 35 を駆動できるようにするために挿入されている。 なう半導体レーザの光出力変動が、情報の再生信 号や、光スポツト制御信号等における信号対雑音 **比を劣化させる。例えば、ディスクからの情報再** 生の場合、回転に伴なうデイスクのばたつきによ り、デイスクと半導体レーザとの間の距離が変化 め し、半導体レーザの光出力変動が生ずる。第2図 はこの状況を示す図である。

第2図において、健軸は、半導体レーザの光出 力(mW)を示し、機能は、デイスクのばたつきによ

るデイスク変位(sm)を示し、実線が、直流電流に よる駆動を行つた場合の光出力の変化を奏わして いる。なお、直流電流による駆動は第3図に示す 如き與線で行なわれる。 第3回において、機能は 電流の大きさ(mA)、横軸は時間(nS)を示してい

第2図において、デイスクが、光スポツト焦点 位置から上10 μm ずれると、半導体レーザ出力 が選ることを示している。これはデイスクからの 反射光のうち、半導体レーザの出射口に帰還され 10 る光量が減るととによる。ディスクの1 gm 以下 の微小な変位によって、上記の大まかな変化以外 に、 1/2毎に細かな光出力変励が生ずる。これ が第1種の低帯域ノイズである。この光出力変動 は、光出力DC分の・10~20の大きさである。 光出力が落ち込んだときは、縦モード多重発掘し ており、このときビデオノイズが増加する。

光スポットの自動焦点制御によつて、光スポッ ト焦点位價を、デイスク変位に追従させることが 鷄 2のノイズは、0 ~ 2GHzにわたる連続スペー級ーできる。しかしデイスクと光スポツト焦点位置と を1#m 以下の精度で一定に保つことは、自動制 御技術をもつてしても困難であり、発掘縦モード の変化に伴なう光出力変動は、自動焦点制御をか けても、除くことは斃かしい。

本発明は、半導体レーザの駆動方法に特徴をも たせることにより、上記の、発振縦モードの変化 に伴なう光出力変動を抑止することである。 第4 図に、本発明の一実施例の構成を示す。第4図の 1,2,3,41,42は、第1図に示したもの 重縦モード発掘とが交互に起こるので、ビデオ帯 30 と同一である。半導体レーザは、直流電流源5と、 高周波電流源6と、2つの電流源から供給され る電流によって駆動される。第4図における、R, L, Cは各々、抵抗、コイル、コンデンサであり **し及びCは、2つの電流源が独立に半導体レーザ** 高周波交流電流によつて駆動することによつて、 反射光帰週による半導体レーザの光出力変動を抑 止することができる。なお、直流電流と髙周放電 流とによる半導体レーザ駆動は、第3回に示す如 く、直流電流(夷線で示す)に高周波電流(点線 で示す)を筐畳した形式でなされる。

> かかる本発明の駆動を用いた場合の作用及び効 果について、図面により説明する。

第5図a~dは、半導体レーザの様モード発振

8

スペクトルを示しており、その総軸は光強度、そ の機輔は波長を示している。直流電流駆動で定常 発振させ、反射光帰還がない場合は、第5回2の ように単一縦モード発振する。反射光燥温がある とデイスクが変動している場合、時間平均してス 5 ペクトルを見れば、第5図bのように多重桜モー ド発振している。

さて、第3図の点線で示したような、直流分と 高周波の交流電流とを重ね合わせた電流で半導体 レーザを駆動すると、発振スペクトルは第5図c のように多重概モード発掘となる。ことで、重要 なことはレーザ発振が高周波でオン・オフされる ように、高剛波電流の振幅を十分大きくする必要 があることである。すなわち、直流分と高間波分 の重ね合わせた電流の最小假は、発振しきい電流 15 より小さくなるようにする。レーザ発振の立ち上 かり時には、均一なスペクトル広がりをもつ半導 体レーザにおいても、いくつかの縦モードがレー ザ発機する。従つて、髙周波でレーザ発掘がオン オフされると、多重様モード発提状態が保たれる 20 ととになる。

高周波電流を飛すことにより、多重縦モード発 綴させると、第2図の点線で示したように、半導 体レーザの光出力はデイスク変位に対して、なめ る。すなわち、単一縦モードと多重縦モードとが 交互に起こることによって生じる第1種の低帯域 ノイズは、完全に抑止される。高恩波駆動により 常に多重線モード発提状態が保たれ、単一線モー 下発機することはないからである。

更に高周波電流駆動により、 第2種のビデオ帯 域ノイズも、かなりの程度抑止される。第5図 d は、反射光帰還があるとき高周波駆動した場合の 発報スペクトルである。 第5図aと第5図cとで はビデオノイズないが、第5図2ではビデオノイ ズ大きく、鮪5図dではビデオノイズが鮪5図b より小さくなる。

第6図は、ビデオノイズレベルが高周波駆動に よって抑止されるととを示す特性曲線図である。 なお、その被軸は反射帰還量を対数表示してある。40 使用したレーザは、CSP迦 (Channeled Substrate Planer) 半導体レーザで、発振し きい電流が60mAのものである。図において、 本発明によらない場合を実設で示し、本発明によ

る場合(直流分 75mAに対し、 1 2 0 MHz, 5 0 mAppの髙周波外を重畳して変調した場合)を点 線で示してある。反射光帰還が100%のとき、 すなわち、SCOOPの場合の光ピックアップの場 合、ビデオノイズは約10dB抑止されている。 従来型の光ヘツドでも数%の反射光帰還は避けら れないが、この場合にも高局波駆励によってピテ オノイズを抑止できることが第6図からわかる。

高周波駆動に使用する周波数に対するビデオノ 10 イズ抑止効果を第了図に示した。但し、特性曲線 はCSPレーザ、直流電流75mA変調電流振幅 5 OmAppでの場合を示している。第7図から周 波数は50MHz以上でノイズ抑止効果が著しい。 これは50MHz以上で凝モード多重発綴となるか らである。なお、第7図において、実練は100 %帰還した場合を示し、一点鎖額は 0.5 %帰還の 場合を示す曲線である。

高周波駆動電流の周波数は、デイスクから再生 しようとする情報の簡波数より、十分高い層波数 である必要があることは当然である。光検出器の 周波数特性を考慮して再生情報の周波数の5倍以 上、好ましくは10倍以上となすのが好ましい。 再生情報の周波数は、ビデオデイスクやPCMオ ーデイオデイスクの場合、1~10 MHzである。 らかに変化し、1/2年の光出力変動は抑止され 25 一方、半導体レーザを、多重度モード発振させる ためには50MHz以上の高周波電流で駆動する必 要がある。発振器、光検出の検出回路の実用上の 観点から数100MHz程度迄を使用する。従って、 50MHz以上の高銅波電流で半導体レーザを駆動 30 すれば、多重縦モード発振によって、光出力変励 を抑止でき、かつ、デイスクからの再生信号より も、十分高い周波数なので、再生信号に不都合な影 顰を及ぼすこともない。すなわち、光検出器及び 検出回路系の、周波欲応答特性は、再生信号帯域 35 までのびており、半導体レーザ駆動の高周波域で は応答しないようにしておけばよい。

> 第8図は、ノイズ抑止効果の高圏波電流の振幅 依存性を示している。但し、第8回は、CSPレ ーザ、発振しきい電流 60mA、直流動作電流 7.5 mA変調電流周波数120MHzにてとつたもので ある。レーザ発振がオン・オフして凝モード多重 となつてはじめてノイズ抑止効果がでる。 第8図 からノイズ抑止効果が

> > $(75 \text{ mA} - 60 \text{ mA}) \times 2 = 30 \text{ mApp}$

以上で署しく、上記のことを支持する。

なお、第8図において、実線は100%帰還の 場合による曲線を示し、一点鎖線は、27%帰還 の場合による曲線を示している。

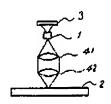
第9図は反射光帰避による半導体レーザノイズ 5 発生を調べる測定系の構成を示す図である。半導 体レーザ1から出た光はレンズ90で平行光束に されてから集光レンズ 91で、デイスク2上に集 光される。半導体レーザ1とデイスク2との間の 距離は約3㎝である。デイスク2は、ポイスコイ ル92によつて光スポツトの魚点深度方向に振動 できるようになつている。レーザ出力は、デイス ク2個とは反対側に出射されるレーザ光を光検出 器3で検出する。光後出器の出力を、CRT93 スペクトルアナライザ95で周波数分析する。レ ーザ駆動電流は直流激5からの直流分と、高周波 発振器6からの交流分との貧ね合わせた電流であ రెం

以上の如く半導体レーザを光源として用いた情 報再生装置において、デイスクからの反射光が半 導体レーザに帰還することによつて生ずるノイズ は、半導体レーザを高周波電流駆動して多重縦モ ード発振させることによって抑止できる。本発明 はSCOOPによる情報再生装置にも、従来還の光 ピツクアップによる情報再生装置にも有効である。 図面の簡単な説明

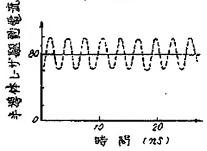
10

第1図は、反射光帰還型の半導体レーザを用い 10 た光ピツクアツプの構成図、第2図は、デイスク 変位に対する半導体レーザ光出力の関係を示した 図、第3図は、半導体レーザの駆動電流の時間変 化を示した図、第4図は本発明の一実施例の構成 を示す図、第5図a~dは、半導体レーザの縦モ 上に表示したり、ビデオアンプ84で増幅した後、15 ード発振スペクトルを示す図、第8,7,8図は、 ピデオノイズレベルが高周波駆動により抑止され るととを説明する図、第9図は、半導体レーザの ノイズを測定する測定系の構成を示す図である。

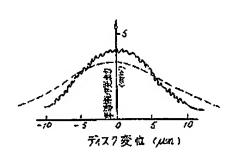
图一张



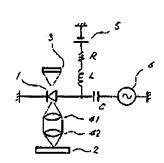
才 3 図

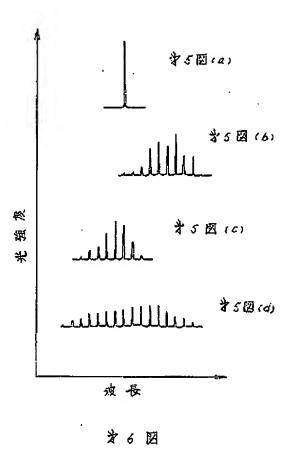


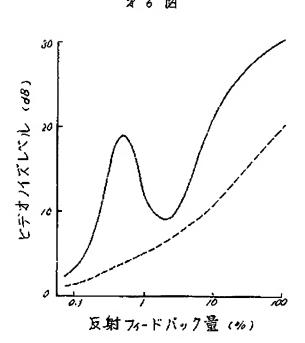
計2図

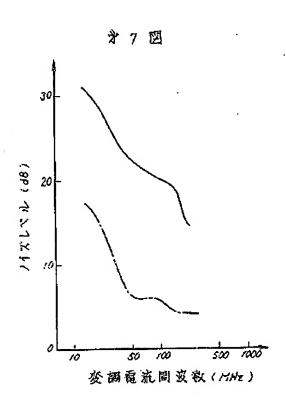


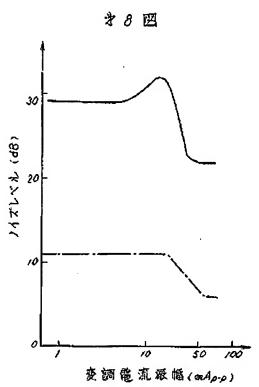
才4四











尹 9 図

